

Hi2600B 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

1. 特性

- 宽输入电压：5-100V
- 平均电流工作模式
- 高效率：最高可达 95%
- 输出电流可调范围 60mA~5A
- 外驱 MOS，最大驱动 50N
- 内置 5V 稳压管
- 固定工作频率 130KHz
- 恒流精度 $\leq\pm 5\%$
- 支持 MODE 半亮长亮切换
- 封装：SOT23-6

2. 应用领域

- 景观亮化洗墙灯
- 汽车照明
- LCD 背光照明
- 建筑照明

3. 说明

Hi2600B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。

芯片集成了高低亮功能，可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时，为高亮模式，MODE 引脚接高电平时，为 1/2 电流的低亮模式。

此外芯片内部集成了 VDD 钳位电路以及过温降电流处理，减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。

芯片采用我司专利的平均电流控制算法固定频率 130kHz 的 PWM 工作模式下，输出电流恒流精度 $\leq\pm 5\%$ ，且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小；芯片内部集成环路补偿，外围电路简洁，系统更加稳定可靠。

4. 应用电路

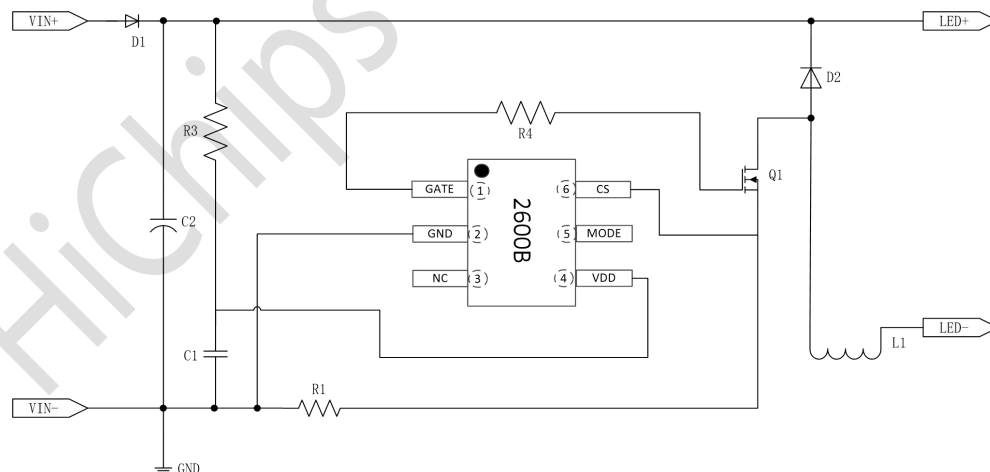
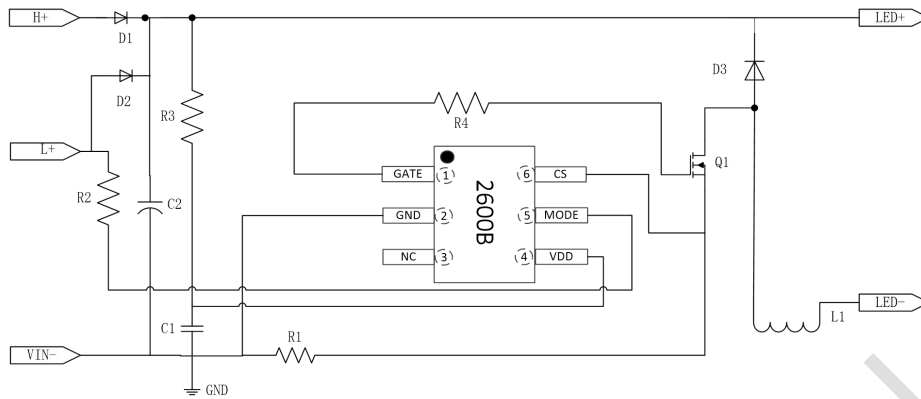


图 4.1 Hi2600B 常亮应用电路



12V 输入高低亮应用电路

5. 管脚配置

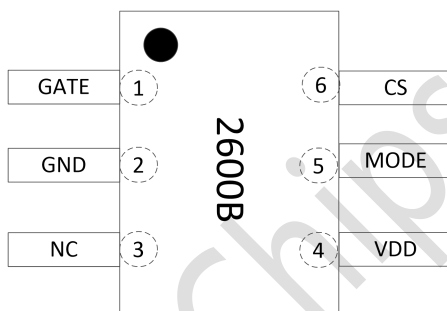


图 5.1 Hi2600B 引脚图

编号	管脚名称	功能描述
1	GATE	NMOS GATE 驱动管脚
2	GND	地
3	NC	NC
4	VDD	芯片工作电源
5	MODE	高低亮切换
6	CS	电流检测脚

6. 极限工作参数

符号	说明	范围	单位
VDD	芯片工作电源	-0.3~7.0	V
V _{CS}	CS 输入电压	-0.3~7.0	V
V _{MODE}	MODE 电压	-0.3~7.0	V
R _{θJA}	PN 结到环境的热阻	140	℃/W
P _D	最大承受功耗（注 2）	0.8	W
T _{STG}	存储温度	-40~150	℃
T _J	工作温度	-40~125	℃
HBM	人体放电模式	>2	KV

注 1：最大输出功率受限于芯片结温，最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 T_{JMAX}，R_{θJA} 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_D = (T_{JMAX} - T_A) / R_{\theta JA}$ 或是极限范围给出的数值中较低值。

7. 结构框图

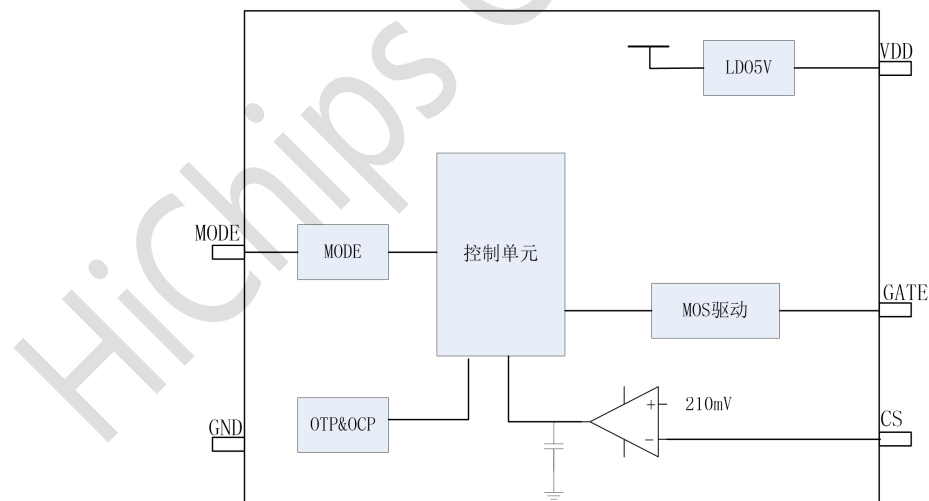


图 7.1 结构框图

8. 电气特性

(除非特殊说明, 下列条件均为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
VDD 工作部分						
I _{DD}	工作电流	F _{sw} =130kHz	-	1.8	-	mA
I _Q	静态电流	V _{DD} =5V		300		uA
V _{DD_clamp}	VDD 钳位电压	I _{VDD} <10mA	-	5.6	-	V
V _{UVLO}	欠电压锁定电压			3.2		V
V _{STUP}	启动电压			3.9		V
V _{DD_HYS}	欠压保护迟滞			0.7		V
CS 输入部分						
V _{CS}	过流判断阈值			400		mV
V _{REF}	恒流控制电压			210		mV
T _{LEB}	LEB 时间		-	200	-	nS
F _{sw}	工作频率			130		kHz
MODE 端口						
R _{MODE}	MODE 下拉电阻			40		Kohm
过温处理						
T _{j,MAX}	最高结温	过温降电流的方式	-	140	-	℃

备注:

- 对于未给定上下限值的参数, 本规范不保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。
- 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。
- 芯片内部结温达到设定温度 (典型值 140°C) 时, 开启降电流功能。

9. 应用说明

Hi2600B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-100V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制。

9.1. 输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.21V 比较以及误差放大，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下：

$$I_{out} = \frac{0.21V}{RCS} A$$

其中 I_{out} 为输出电流， Rcs 为系统的检流电阻。

9.2. 芯片启动

系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容器充电，当电源电压高于 3.9V 后，芯片电路开始工作，直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.6V 左右，芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入的电阻 R3 提供。

9.3. MODE 设置

通过给 MODE 设置不同电平，可以让芯片实现不同的亮度功能。当 MODE 外接电阻拉高至 VDD 时，芯片进入 1/2 低亮模式，MODE 悬空或接地时，芯片进入高亮工作模式。

9.4. 电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到电感纹波大小及连续或非连续工作模式。若工作在临界模式时的电感值为：

$$L_{BCM} = \frac{V_{LED} \times (VIN - V_{LED})}{2 \cdot VIN \cdot I_{LED} \cdot f_{sw}}$$

为保证系统的输出恒流特性，应用当中电感值的选择要大于 L_{BCM} ，电感电流应工作在连续模式。

9.5. 续流二极管

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下：

$$I_{avg_diode} = I_{OUT} \times \frac{t_{OFF}}{t_{ON} + t_{OFF}}$$

注意，二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率，建议选择快恢复的肖特基二极管。

9.6. 供电电阻

芯片的主要是通过一个供电电阻 R1 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流，通常情况下，VDD 满足

$$VDD = VIN - I_D \times R_3$$

公式中可以看出，R1 过大会导致系统供电不足，过小则会导致功耗过大、芯片过热。而且该电阻的选择还与开关频率有一定的关系，系统频率越高，需要 R1 的阻值越小。

下面以一个输出电流为 1A 的系统给出设计指导，电感为 33uH，

VIN (V)	5	12	24	36	48
R3(Ω)	100	3K	6K	9K	14K

9.7. VDD 旁路电容

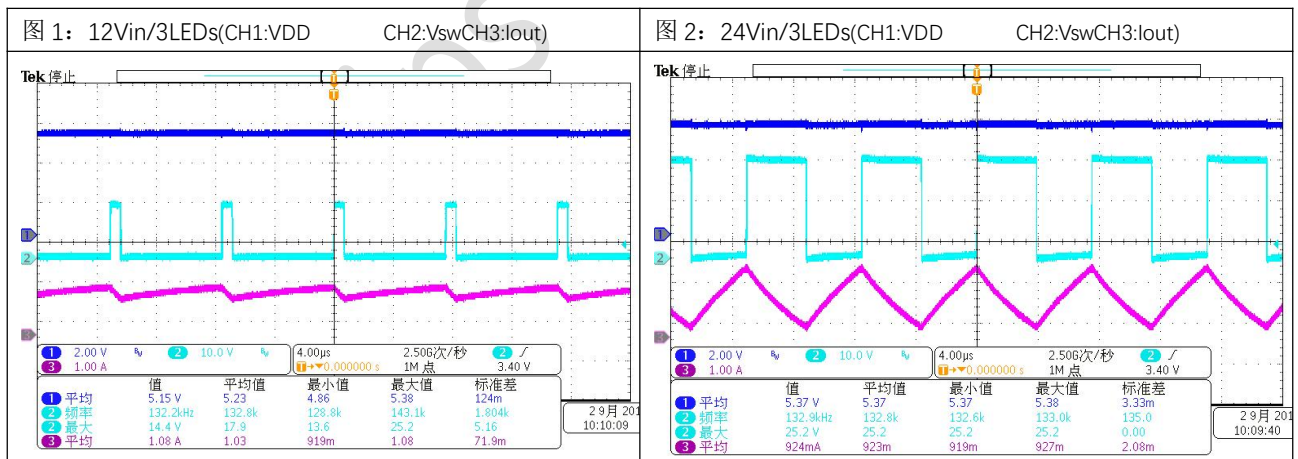
VDD 引脚需要并联一个 1.0uF 以上的旁路电容，PCB 布板时,VDD 电容需要紧挨着端口布局。

9.8. 过温处理

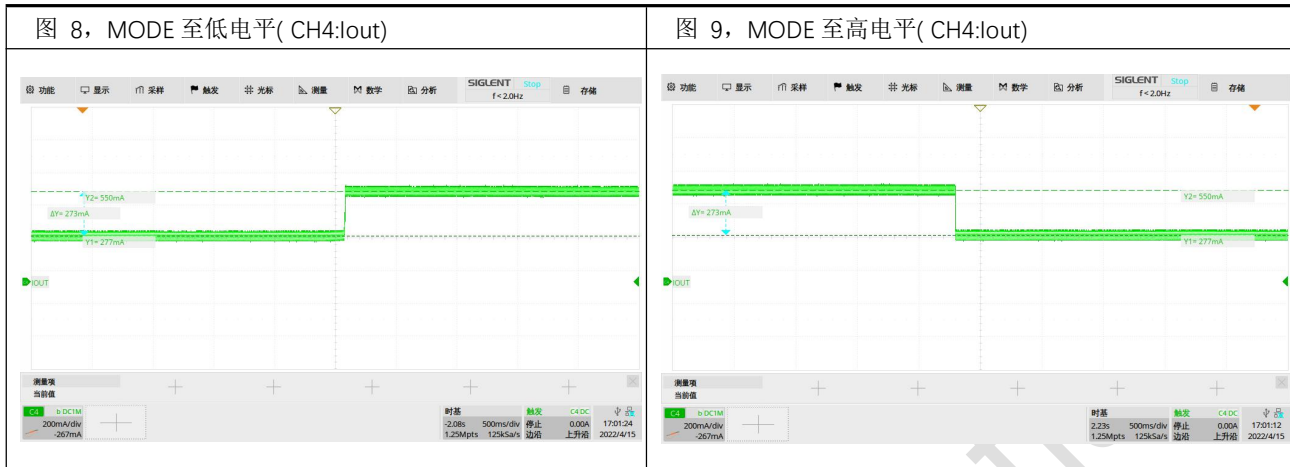
当芯片温度过高时，系统会限制输入电流，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用；随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

10. 典型工作波形

10.1. 稳态波形



10.2. MODE 调光波形



11. PCB 设计注意事项

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高系统 PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大；
2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜，CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜，都应尽可能长度短、线宽大；
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局，且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接；
4. 系统的输入电容尽可能靠近 Hi2600B 系统布局，保证输入电容达到最好的滤波效果；

12. 封装信息

